








 life.augmented	<h2>STD11N60M2-EP</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STD11N60M2-EP</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: N-CHANNEL 600 V, 0.550 OHM TYP.,</p> <p>Datenblätter:  STD11N60M2-EP.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STD11N60M2-EP
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	N-CHANNEL 600 V, 0.550 OHM TYP.,
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	MDmesh™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	595 mOhm @ 3.75A, 10V
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	390pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Tc)

STD11N60M2-EP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STD11N60M2-EP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STD11N60M2-EP STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STD11N60M2-EP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STD11NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A DPAK</p>	 <p>STD116GK16B Sirectifier IGBT Modules</p>	 <p>STD11N65M5 STMicroelectronics MOSFET N CH 650V 9A DPAK</p>	 <p>STD116GK18 Sirectifier IGBT Modules</p>
 <p>STD116GK18B Sirectifier IGBT Modules</p>	 <p>STD11N65M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 7A DPAK</p>	 <p>STD11N50M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 8A DPAK</p>	 <p>STD11NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 9A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STD11N60M2-EP STMicroelectronics	STD11N60M2-EP Datenblatt	STD11N60M2-EP-Datenblätter	STD11N60M2-EP PDF	STMicroelectronics STD11N60M2-EP
STD11N60M2-EP Electronic	STD11N60M2-EP-Komponenten	STD11N60M2-EP-Verteiler	STD11N60M2-EP-Bild	STD11N60M2-EP-Teil
STD11N60M2-EP Preis	STD11N60M2-EP Hersteller	STD11N60M2-EP Bild	STD11N60M2-EP Aktie	STD11N60M2-EP Inventar
STD11N60M2-EP Neu	STD11N60M2-EP Original	STD11N60M2-EP garantiert	STD11N60M2-EP RFQ	STD11N60M2-EP Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited